

Vorläufige Daten
Preliminary Data
Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	600	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	1200	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	35000 33000	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

		min. typ. max.				
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 600\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1,85	2,45	V
	$I_F = 600\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F	1,80		V
	$I_F = 600\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1,75		V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 600\text{ A}, -di_F/dt = 11000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		535		A
	$V_R = 600\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	655		A
	$V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		680		A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 600\text{ A}, -di_F/dt = 11000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		50,5		μC
	$V_R = 600\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r	94,0		μC
	$V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		110		μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 600\text{ A}, -di_F/dt = 11000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		27,0		mJ
	$V_R = 600\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	48,5		mJ
	$V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		54,5		mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface material	R_{thJH}			0,126	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\text{ op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

Vorläufige Daten Preliminary Data

Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	4,0		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		29,0 23,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		23,0 11,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 400		
Relativer Temperaturindex (elektr.) RTI Elec.	Gehäuse housing	RTI	140		°C
			min.	typ.	max.
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L _{sCE}		20	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T _H = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC+EE'}		0,42	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T _{stg}	-40		125 °C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur Maximum baseplate operation temperature		T _{BPmax}			125 °C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	2,5	-	5,0 Nm
Gewicht Weight		G		340	g

Lagerung und Transport von Modulen mit TIM => siehe AN2012-07
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07